

Silicon Diode

BY458

1200V / 2A

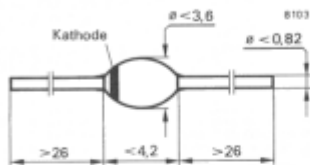
DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

BY 448 · BY 458**Silizium-Mesa-Dioden****Anwendung:** Hochspannungsgleichrichter**Besondere Merkmale:**

- Glaspassivierte Sperrschicht
- Hermetisch dichtes Gehäuse

Abmessungen in mm

Sinterglasgehäuse
SOD 57
Gewicht max. 0,4 g

Bestempfung: Klartext**Absolute Grenzwerte**

		BY 448	BY 458	
Sperrspannung	U_R	1500	1200	V
Stoßdurchlaßstrom $t_p = 10 \text{ ms}$	I_{FSM}	30		A
Durchlaßstrom, Mittelwert	I_{FAV}	2		A
Sperrschichttemperatur	T_j	140		°C
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	- 65 ... + 175		°C

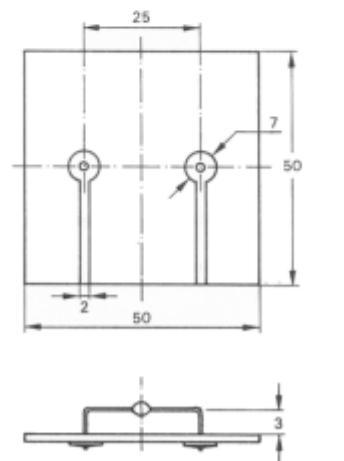
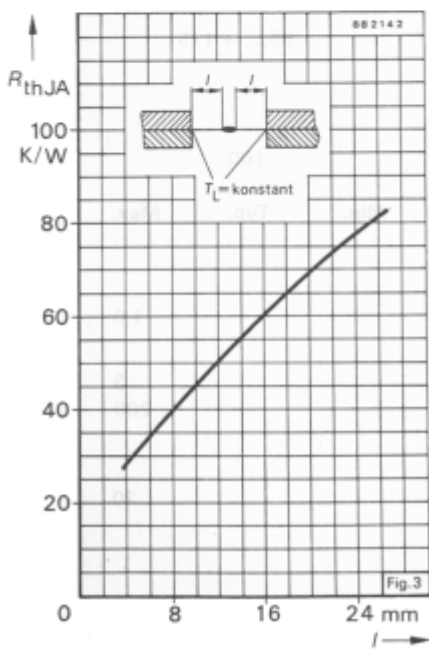
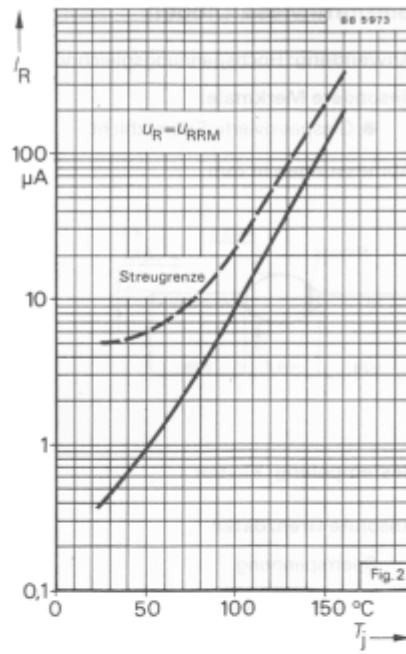
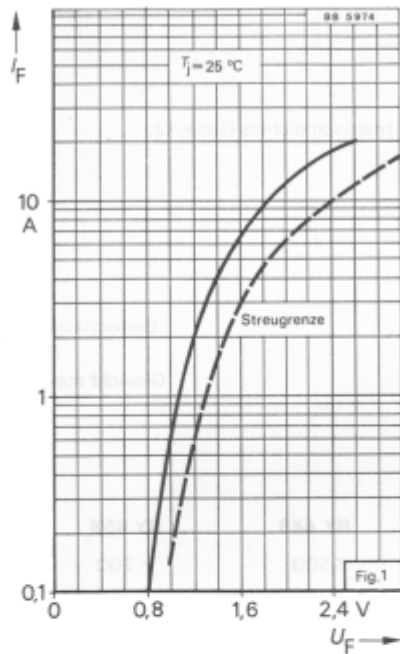
Maximaler Wärmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung auf Leiterplatte im Raster 25 mm	R_{thJA}	100		K/W
---	------------	-----	--	-----

Kenngrößen $T_j = 25 \text{ °C}$, falls nicht anders angegeben

		Min.	Typ.	Max.	
Durchlaßspannung $I_F = 3 \text{ A}$	U_F			1,6	V
Sperrstrom $U_R = U_{RSM}$ $T_j = 140 \text{ °C}$	I_R			3	μA
	I_R			200	μA
Gesamtrückwärtserholzeit $I_F = 1 \text{ A}$, $\frac{-d_{IF}}{dt} = 0,05 \text{ A}/\mu\text{s}$	t_{rr}			20	μs

BY 448 · BY 458



Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstärke: 1,5 mm
 $R_{thJA} \approx 100 \text{ K/W}$

Fig. 4

86 1732